

Bộ Giáo dục và Đào tạo Đại học bách Khoa Hà nội	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--	---

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH: GIÁO SƯ Mã hồ sơ:	ẢNH 4x6
---	---------

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống:)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Vũ Ngọc Tước

2. Ngày tháng năm sinh: 3/11/1964. Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt nam

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: xã Thái Phú, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 22 phố Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội.

6. Địa chỉ liên hệ: Phòng 14-4 Nhà A2, Chung cư 229 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.

Điện thoại nhà riêng: 02436284355; Điện thoại di động: 0989631799;

Địa chỉ E-mail: tuoc.vungoc@hust.edu.vn

7. Quá trình công tác:

– Từ năm 01/1992 đến năm 07/2019: Trường Đại học bách Khoa Hà nội, Viện Vật lý kỹ thuật., số 01 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà nội.

Chức vụ: Hiện nay: Trưởng Bộ môn Vật lý lý thuyết; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Bộ môn.

Cơ quan công tác hiện nay (khoa, phòng, ban; trường, viện; thuộc Bộ): Viện Vật lý kỹ thuật; Đại học bách Khoa Hà nội; Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Địa chỉ cơ quan: số 01, Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà nội.

Điện thoại cơ quan: 38693350.

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học;: Không có.

8. Đã nghỉ hưu từ tháng năm

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi có hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):

.....

9. Học vị:

– Được cấp bằng ĐH ngày 26 tháng 06 năm 1987, ngành Vật lý, chuyên ngành: Vật lý

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): ĐH Tổng hợp Quốc gia Belarus (Tp. Minsk - Liên xô cũ)/Prospekt Nezavisimosti 4, Minsk, Belarus

– Được cấp bằng TS ngày 13 tháng 03 năm 1991, ngành Vật lý, chuyên ngành: Vật lý Toán

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Belarus (Tp. Minsk - Liên xô cũ)/Prospekt Nezavisimosti 4, Minsk, Belarus

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS thời gian: 10/10/2004, ngành: Vật lý

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội đồng II: Vật lý, Luyện kim).

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Hội đồng ngành Vật lý.

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

(1) Vật lý tính toán trên các cấu trúc thấp chiều và nano bán dẫn.

(2) Mô hình hóa và mô phỏng các cấu trúc và đặc tính vật liệu mới lạ từ các nguyên lý ban đầu.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 3 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS;

- Đã công bố (số lượng) 20 bài báo KH trong nước, 38 bài báo KH trên tạp chí có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) bằng sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Số lượng sách đã xuất bản 2, trong đó có 2 thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Liệt kê không quá 5 công trình KH tiêu biểu nhất:

Bài báo khoa học tiêu biểu								
TT	Tên bài báo	Tên tác giả	Loại công bố (chỉ số IF)	Tên tạp chí, kỉ yếu khoa học	Tập	Số	Trang	Năm xuất bản
1	Predicted Binary Compounds of Tin and Sulfur (TG chính)	VN Tuoc, TD Huan	SCI (KHTN-CN) (IF: 4.309)	Journal of Physical Chemistry C (Q1)	122	30	17067-17072	2018
2	Layered structures of organic/ hybrid halide perovskites (TG chính)	TD Huan, VN Tuoc, NVMinh	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.736)	Physical Review B (Q1)	93	9	094105	2016
3	Universality of returning electron wave packet in high-order harmonic generation with midinfrared laser pulses	AT Le, H Wei, C Jin, V N Tuoc, T Morishita, CD Lin	SCI (KHTN-CN) (IF: 9.227)	Physical Review Letters (Q1)	113	3	033001	2014
4	The self-consistent charge density functional tight binding study on wurtzite nanowire (TG chính)	VN Tuoc	SCI (KHTN-CN) (IF: 2.644)	Computational Materials Science (Q2)	49	4	S161-S169	2010
5	Random Piezoelectric Field in Real [001]-Oriented Strain-Relaxed Semiconductor Heterostructure,	DN Quang, VN Tuoc, NH Tung, TD Huan	SCI (KHTN-CN) (IF: 9.227)	Physical Review Letters (Q1)	89	7	077601	2002

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

– Bằng khen của Bộ ĐH Belarus, cấp Bộ ĐH Belarus.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT, cấp Bộ trưởng Bộ GD và ĐT . Mô tả: (2 lần) năm 2006 (17/8/2006, QĐ 3962) và năm 2016 (10/10/2016 QĐ 2937) .

– Danh hiệu CSTĐ cấp Bộ, cấp Bộ GD và ĐT. Mô tả: năm 2017 (28/3/2017 QĐ 985).

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH và CN, cấp Bộ KH và CN. Mô tả: năm 2016 (10/10/2016 QĐ 2937).

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định): Không có.

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/ PHÓ GIÁO SƯ

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá):

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cũng như các nghĩa vụ của CB GD, thực hiện đầy đủ các quy định của Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động nhà trường. Giữ gìn phẩm chất, uy tín danh dự của nhà giáo. Tôn trọng nhân cách và đối xử công bằng với người học. Sống trong sáng lành mạnh và có uy tín trong đồng nghiệp và sinh viên, tạo ảnh hưởng tốt trong nhà trường và ngoài xã hội. Chấp hành đầy đủ chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước.

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

Tổng số 22 năm.

Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

TT	Năm học	Hướng dẫn NCS		HD luận văn ThS	HD đồ án, khóa luận tốt nghề nghiệp ĐH	Giảng dạy		Tổng số giờ giảng/số giờ quy đổi
		Chính	Phụ			ĐH	SĐH	
1	2015-2016	1	0	0	0	162	188	226/350
2	2014-2015	1	0	0	0	262	188	205/450
3	2013-2014	1	0	1	0	378	210	210/588
3 năm cuối								
1	2016-2017	1	0	0	0	195	116	190/311
2	2017-2018	1	0	0	0	225	170	210/395
3	2018-2019	0	0	0	0	486	18	315/504

3. Ngoại ngữ:

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: tiếng Anh và tiếng Nga

a) Được đào tạo ở nước ngoài :

– Học ĐH ; Tại nước: Belarus (Liên xô cũ) từ năm: 1982-1987

– Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; Tại nước: Belarus (Liên xô cũ) năm: 1988-1991

– Thực tập dài hạn (> 2 năm) ; Tại nước:

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :

– Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ... ; Số bằng: ... ; Năm cấp: ...

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :

– Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh

– Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Chương trình tiên tiến, ĐH Bách khoa Hà nội [<https://www.hust.edu.vn/cac-chuong-trinh-dao-tao-tien-tien>]

d) Đối tượng khác ; Diễn giải: Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL (Test of English as a Foreign Language) lần 1: 567 scores (12/1992); Chứng chỉ TOEFL lần 2: 560 scores (6/2001); Tôi có thời gian làm việc bằng tiếng Anh ở nước ngoài: (i) thực tập sau TS (postdoc) tại ĐH Paderbon (Germany) (1/2003-1/2004), (ii) các chương trình trao đổi học giả (visiting scholar) tại ĐH Arizona State Uni. (ASU), Arizona (US) (11/2006-5/2007) (iii) ĐH Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), Illinois (US) (11/2009-11/2010)

3.2. Tiếng Anh giao tiếp (văn bằng, chứng chỉ): TOEFL

4. Hướng dẫn thành công NCS làm luận án TS và học viên làm luận văn ThS (đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng):

TT	Họ tên NCS hoặc HV	Đối tượng		Trách nhiệm HD		Thời gian hướng dẫn từđến.....	Cơ sở đào tạo	Năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HV	Chính	Phụ			

1	Nguyễn Thành Tiên	✓		✓	12/2006 đến 10/2011	Viện Vật lý (Viện hàn lâm KH&CN Việt nam)	2011
2	Lê Thị Hồng Liên	✓	✓		01/2011 đến 05/2015	Trường ĐH Bách Khoa HN	2015
3	Nguyễn Thị Thảo	✓	✓		05/2014 đến 10/2017	Trường ĐH Bách Khoa HN	2017

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

*Giai đoạn Trước Phó Giáo Sư

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Viết một mình hoặc chủ biên, phần biên soạn	Xác nhận của CSGDDH (số văn bản xác nhận sử dụng sách)
1	Mô hình hóa và Mô phỏng bằng máy tính	Sách chuyên khảo	Nhà xuất bản giáo dục, 2001	1	Viết một mình	
2	Ngôn ngữ lập trình 1 Mathematica 3.0	Giáo trình (ĐH, SDH)	Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2000	1	Viết một mình	77/ĐHBK-ĐT

*Giai đoạn Sau Phó Giáo Sư Không có

- Trong đó, sách chuyên khảo xuất bản ở NXB uy tín trên thế giới sau khi được công nhận PGS (đối với ứng viên chức danh GS) hoặc cấp bằng TS (đối với ứng viên chức danh PGS):

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu:

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm)
1	ĐT NAFOSTED Nghiên cứu mô phỏng từ các nguyên lý ban đầu các cấu trúc Nano bán dẫn thấp chiều.	Chủ nhiệm	103.02.100.09, Nhà nước	12/2009 đến 12/2011	07/04/2014
2	ĐT NAFOSTED Nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng các cấu trúc nano thấp chiều hướng tới các ứng dụng trong năng lượng và nano sinh học.	Chủ nhiệm	103.02-2011.20, Nhà nước	06/2012 đến 06/2014	24/11/2014
3	ĐT NAFOSTED Nghiên cứu mô hình hóa lượng tử và mô phỏng động lực học phân tử các cấu trúc và đặc tính vật liệu mới lạ hướng tới ứng dụng trong nano năng lượng và nano-quang/spin điện tử.	Chủ nhiệm	103.01-2014.25, Nhà nước	02/2015 đến 02/2017	01/03/2017
4	ĐT cấp Bộ GD và ĐT: Mô hình hóa và mô phỏng cấu trúc vật liệu và linh kiện nano bán dẫn hợp kim dị chất dạng lớp	Chủ nhiệm	B2005-28-196, Bộ/Sở	01/2005 đến 12/2006	20/06/2007

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1. Bài báo khoa học đã công bố:

*Giai đoạn Trước Phó Giáo Sư

TT	Tên bài báo	Số tác giả	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học	Tạp chí quốc tế uy tín (và IF) (*)	Số trích dẫn của bài báo	Tập/Số	Trang	Năm công bố
----	-------------	------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------	-------	-------------

1	Free Particle Model for a Disordered Two-Dimensional Electron Gas in a Perpendicular Magnetic Field (TG chính)	3	Communications in Physics			Supplement /	18-22	2004
2	Atomistic transport study direct tunneling current through the ultra-thin Si/SiO ₂ structure, (TG chính)	3	Proceedings of the 7th Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, 28 Mar.-3 Apr. 2004, Halong, Vietnam NXB ĐH BK HN			/	94-98	2004
3	Structurally relaxed models of the Si(100)-Si _{1-x} Ge _x interface, (TG chính)	4	Proceedings of the 7th Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, 28 Mar.-3 Apr. 2004, Halong, Vietnam NXB ĐH BK HN			/	309-312	2004
4	Roughness-induced piezoelectric scattering in lattice mismatched semiconductor quantum wells,	3	Physical Review B (Q1)	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.736)	26	68/19	195316	2003
5	Strain fluctuations in a real [001]-oriented zincblende structure surface quantum well	4	Physical Review B (Q1)	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.736)	16	68/15	153306	2003
6	Influence of the interface roughness profiles on the random piezoelectric field in a lattice-mismatched quantum well, (TG chính)	2	Communications in Physics			13/4	193-205	2003
7	Influence of the interface roughness profile on the electron transport properties of a lattice mismatched quantum wells made of zinc-blende structural material, (TG chính)	2	Proceedings of the 6th German-Vietnamese Seminar on Physics and Engineering, 25-31 May 2003, Chemnitz, Germany, (2003). NXB ĐH BK HN			/	214-225	2003
8	Theory for coexistence of ferromagnetism and superconductivity in UGe ₂ ,	2	Proceedings of 6th German-Vietnamese seminar on Physics & Engineering, 25-31 May 2003, Chemnitz, Germany NXB ĐH BK HN			/	15-20	2003
9	Random Piezoelectric Field in Real [001]-Oriented Strain-Relaxed Semiconductor Heterostructure,	4	Physical Review Letters (Q1)	SCI (KHTN-CN) (IF: 9.227)	24	89/7	077601	2002

10	Band edge fluctuation in real zinc-blende structure surface quantum well,	3	Proceedings of the 5th German-Vietnamese Seminar on Physics and Engineering , 25 Feb -2 Mar 2002, Hue, Vietnam NXB ĐH BK HN			/	19-24	2002
11	Random piezoelectric field in a real strained-relaxed surface quantum well,	3	Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 27, Cửa lò 02-06/8/2002 TT Vật lý lý thuyết			/	227-232	2002
12	Roughness-induced scattering mechanism in lattice-mismatched surface quantum wells of zincblende material,	4	Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 27, Cửa lò 02-06/8/2002 TT Vật lý lý thuyết			/	204-208	2002
13	Giới thiệu 2 phần mềm dựng hình phân tử mã nguồn mở MG và gOpenMol (The two molecular visualization packages: Molecular Graphics (MG) and gOPENMol)	3	Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5 Ứng dụng tin học trong hóa học và công nghệ hóa học, Hà Nội, 11-2001 NXB ĐH QG HN			/	9-17	2001
14	Ứng dụng phần mềm Mathematica 3.0 trong giảng dạy Vật lý	1	Tuyển tập báo cáo hội thảo phát triển công cụ tin học trợ giúp giảng dạy nghiên cứu và ứng dụng toán học, Hà Nội 9-10/4/1999			/	345-351	1999
15	Модификация операторного метода решения уравнения шредингера для систем с нарушенной симметрией, (TG chính)	2	Известия Академии наук БССР = Весці Акадэміі навук БССР (Thông tin của Viện Hàn lâm Bela-rus)			2/	75-80	1991
16	Analytical approximation for the thermodynamic properties of a diatomic gas,	2	Chemical Physics Letters (Q2)	SCI (KHTN-CN) (IF: 1.901)	5	150/1,2	78-81	1988

*Giai đoạn Sau Phó Giáo Sư

TT	Tên bài báo	Số tác giả	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học	Tạp chí quốc tế uy tín (và IF) (*)	Số trích dẫn của bài báo	Tập/Số	Trang	Năm công bố
17	Using nanotubes to study the phonon spectrum of two-dimensional materials,	3	Physical Chemistry Chemical Physics (Q1)	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.567)		21/	5215-5223	2019

18	Theoretical predictions of two-dimensional covalent organic frameworks (COF) with hexagonal topologies	3	Journal of Physics: Conference Series (Scimago index: 65)	Scopus (KHTN-CN)	1274 /	012010, doi:10.1088/1742-6596/1274/1/012010	2019
19	Theoretical predictions of two-dimensional covalent organic frameworks (COF) with triangular topologies	3	Journal of Physics: Conference Series (Scimago index: 65)	Scopus (KHTN-CN)	1274/	012009, doi:10.1088/1742-6596/1274/1/012009	2019
20	Predicted Binary Compounds of Tin and Sulfur (TG chính)	2	Journal of Physical Chemistry C (Q1)	SCI (KHTN-CN) (IF: 4.309)	122/30	17067-17072	2018
21	Computational predictions of zinc oxide hollow structures (TG chính)	3	Physica B: Condensed Matter (Q3)	SCI (KHTN-CN) (IF: 1.453)	1 532 /	15-19	2018
22	Computational predictions of the new Gallium Nitride nanoporous structures.	4	Journal of Physics: Conference Series (Scimago index: 65)	Scopus (KHTN-CN)	1034/1	012009	2018
23	Theoretical prediction of low-density hexagonal ZnO hollow structures (TG chính)	4	Journal of Applied Physics (Q2)	SCI (KHTN-CN) (IF: 2.328)	5 120/14	142105	2016
24	High-pressure phases of Mg ₂ Si from first principles	5	Physical Review B (Q1)	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.736)	14 93/9	094109	2016
25	Layered structures of organic/ hybrid halide perovskites (TG chính)	3	Physical Review B (Q1)	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.736)	28 93/9	094105	2016
26	Density functional theory based tight binding study on theoretical prediction of low-density nanoporous phases ZnO semiconductor materials (TG chính)	4	Journal of Physics: Conference Series (Scimago index: 65)	Scopus (KHTN-CN)	3 726/1	012022	2016

27	Theoretical Prediction of ZnO Nanoporous Allotropes with Triangular Hollow	2	VNU Journal of Science: Mathematics-Physics			32/3	1	2016
28	Universality of returning electron wave packet in high-order harmonic generation with midinfrared laser pulses	6	Physical Review Letters (Q1)	SCI (KHTN-CN) (IF: 9.227)	34	113/3	033001	2014
29	Impact of Surface on the d0 Ferromagnetism of Lithium-Doped Zinc Oxide Nanowires (TG chính)	3	IEEE Transactions on Magnetics (Q3)	SCI (KHTN-CN) (IF: 1.651)	4	50/6	2400407(1-7)	2014
30	First-Principles Study on Crystal Phase Superlattice Nanowires Heterostructures (TG chính)	4	Journal of Physics: Conference Series (Scimago index: 65)	Scopus (KHTN-CN)		537/	012002	2014
31	A First Principles Study on Electronic and Magnetic Properties of Defects in ZnO/GaN Core-shell Nanowire Heterostructures	4	Communications in Physics			24/3S1	127-135	2014
32	Thermodynamic stability of alkali-metal-zinc double-cation borohydrides at low temperatures	8	Physical Review B (Q1)	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.736)	25	88/2	024108	2013
33	Low-energy structures of zinc borohydride Zn(BH4)2 5 Error: Reference source not found	5	Physical Review B (Q1)	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.736)	22	86/22	224110	2012
34	Modeling study on the properties of GaN/AlN core/shell nanowires by surface effect suppression (TG chính)	3	Physica status solidi (b) (Q3)	SCI (KHTN-CN) (IF: 1.454)	10	249/6	1241-1249	2012
35	Size-induced structural transition in ZnO prismatic nanoparticles (TG chính)	2	Physica status solidi (b) (Q3)	SCI (KHTN-CN) (IF: 1.454)	5	249/3	535-543	2012
36	Density Functional Based Tight Binding Study on Wurtzite ZnS Nanowires,	3	Communications in Physics			22/4	317-326	2012

37	Density Functional Based Tight Binding Study on Wurtzite ZnO Prismatic Nanoparticles	3	Communications in Physics		1	21/3	235-243	2011
38	Density Functional Based Tight Binding Study on Wurtzite Core-Shell Nanowires Heterostructures ZnO/ZnS	4	Communications in Physics		2	21/3	225-233	2011
39	The self-consistent charge density functional tight binding study on wurtzite nanowire (TG chính)	1	Computational Materials Science (Q2)	SCI (KHTN-CN) (IF: 2.644)	18	49/4	S161-S169	2010
40	First Principle Study on AlN Nano Wire (TG chính)	2	Communications in Physics			20/3	255-264	2010
41	Retrieving Molecular Structural Information and Tracking HNC/HCN Isomerization Process with High Harmonic Generation by Ultrashort Laser Pulses,	4	Communications in Physics			20/1	1-9	2010
42	First Principle Study on Domain Matching Epitaxy Growth of Hetero-interface AlN(001) on Si(111)	1	Communications in Physics			19/2	117-123	2009
43	First principle study on the Domain Matching Epitaxy growth of GaN/Si(111) hetero-interface,	1	Journal of Materials Transactions (Q3)	SCI (KHTN-CN) (IF: 0.764)	2	49/11	2491 – 2496	2008
44	Ensemble Monte Carlo simulation of Silicon-On-Insulator ultra-thin-body MOSFET, (TG chính)	2	Physics and Engineering in Evolution - Proceedings of the 11th Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, 31/3 – 5/4, 2008, Nha Trang, Vietnam, NXB KH và KT			/	p.22-26.	2008
45	Quantum and transport lifetimes due to roughness-induced scattering of a two-dimensional electron gas in wurtzite group-III-nitride heterostructures,	6	Physical Review B (Q1)	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.736)	19	74/20	205312 (1-14)	2006

46	Low-temperature Mobility of Holes in Si/SiGe p-channel Heterostructures Using Multiple Scattering Theory, (TG chính)	2	Communications in Physics			16/4	199-208	2006
47	Effect of sheet polarization charges on the electron mobility in an AlGaIn/GaN quantum well,	5	Communications in Physics			16 /Supplement	29-42	2006
48	State of different from (π,π) nesting vector in Q2D material having nesting character	3	Proceedings of the International Conference on Engineering Physics, Hanoi 9-12th Oct. 2006 NXB ĐH BK HN			/	272-274	2006
49	Two-dimensional electron gas in a uniformly-doped group III-Nitride-based hetero-structure,	3	Proceedings of the International Conference on Engineering Physics, Hanoi 9-12th Oct. 2006 NXB ĐH BK HN			/	253-258	2006
50	Roughness-induced mechanisms for scattering of electrons in wurtzite group III-nitride heterostructures,	5	Physical Review B (Q1)	SCI (KHTN- CN) (IF: 3.736)	24	72/24	245303 (1-13)	2005
51	Roughness-induced piezoelectric charges in wurtzite group III-nitride heterostructure,	5	Physical Review B (Q1)	SCI (KHTN- CN) (IF: 3.736)	10	72/11	115337 (1-9)	2005
52	Quantum transport study of the resonant tunneling in Si _{1-x} Gex/Si multiple barrier structure, (TG chính)	2	Proceedings of the Osaka Univ.-Asia Pacific-Vietnam National Univ. Forum, Hanoi, 27-29 Sep. 2005, ISBN4-87259-204-2 C3040 (in tại Osaka, Nhật bản)			/	19-23	2005
53	Dependence of the nesting vector on doping and its role in the phase transitions in Q2D systems having nesting character,	3	Proceedings of the 8th German-Vietnamese Seminar on Physics and Engineering, 3-8th Apr. 2005, Erlangen, Germany NXB ĐH BK HN			/	14-19	2005
54	Nghiên cứu độ linh động của điện tử trong cấu trúc nitride-III dị chất ở nhiệt độ thấp và mật độ điện tử cao (TG chính)	5	Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 6 - Vật lý lý thuyết Quang học Quang phổ học, Hà Nội 23- 25/11/2005 NXB KH và KT			/	134-137	2005

55	Thăng giáng mật độ không đồng nhất của các điện tích áp hai chiều trong cấu trúc dị tính AlGaIn/GaN,	5	Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 6 - Vật lý lý thuyết Quang học Quang phổ học, Hà Nội 23-25/11/2005 NXB KH và KT			/	117-120	2005
56	Nghiên cứu mô phỏng động lực học phân tử - nguyên lý ban đầu các đặc trưng cấu trúc của hợp kim giả nhị phân Al _x Ga _{1-x} N, (TG chính)	2	Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 6 - Vật lý lý thuyết Quang học Quang phổ học, Hà Nội 23-25/11/2005 NXB KH và KT			/	109-112	2005
57	Mô hình hóa lượng tử tự hợp các thiết bị có cấu trúc dị chất gốc GaN (TG chính)	2	Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 6 - Vật lý lý thuyết Quang học Quang phổ học, Hà Nội 23-25/11/2005 NXB KH và KT			/	44-47	2005
58	Low-temperature mobility of holes in Si/SiGe p-channel heterostructures,	4	Physical Review B (Q1)	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.736)	21	70/19	195336 (1-10)	2004

- Trong đó, bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín sau khi được công nhận PGS hoặc cấp bằng TS:

Chú thích: (*) gồm SCI, SCIE, ISI, Scopus (KHTN-CN); SSCI, A&HCI, ISI và Scopus (KHXXH-NV); SCI nằm trong SCIE; SCIE nằm trong ISI; SSCI và A&HCI nằm trong ISI.

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích:

*Giai đoạn Trước Phó Giáo Sư Không có.

*Giai đoạn Sau Phó Giáo Sư Không có.

- Trong đó, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích cấp sau khi được công nhận PGS hoặc cấp bằng TS:

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế (Tên giải thưởng, quyết định trao giải thưởng,...):

*Giai đoạn Trước Phó Giáo Sư

Không có.

*Giai đoạn Sau Phó Giáo Sư

TT	Tên giải thưởng	Cơ quan/tổ chức ra quyết định	Số quyết định và ngày, tháng, năm	Số tác giả
1	Giải thưởng KH quốc tế Bernd Rode của Hội các trường ĐH Á Âu dành cho NCV chính năm 2016 ASEAN-European Academic University Network (ASEA-UNINET) Bernd Rode Award for Senior Researcher 2016 https://asea-uninet.org/scholarships-grants/bra-laureates-2016	ASEAN-European Academic University Network (ASEA-UNINET) Award for Senior Researcher 2016	, 15/2/2016	2

- Trong đó, giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc cấp bằng TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học:

TT	Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ	Vai trò: Chủ trì/Tham gia	Tên cơ sở giáo dục đại học
1	Ứng viên là thành viên HĐ xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ (CTĐT 2009) và phát triển CTĐT 2017 cho đến nay. Ứng viên là người phụ trách chính cho việc xây dựng CTĐT Thạc sĩ Vật lý lý thuyết và Vật lý toán của Trường ĐHBK HN.	Tham gia	Trường ĐH Bách khoa Hà nội

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín:

- Thời gian được cấp bằng TS, được bổ nhiệm PGS:
- Giờ chuẩn giảng dạy:
- Công trình khoa học đã công bố:
- Chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ:
- Hướng dẫn NCS, ThS:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngày..... tháng..... năm 201...

Người đăng ký

(Ghi rõ họ tên, ký tên)

D. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NƠI ĐANG LÀM VIỆC

– Về những nội dung "Thông tin cá nhân" ứng viên đã kê khai.

– Về giai đoạn ứng viên công tác tại đơn vị và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn này.

(Những nội dung khác đã kê khai, ứng viên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật).

..., ngày.....tháng.....năm 201...

Thủ trưởng cơ quan

(Ghi rõ họ tên, ký tên, đóng dấu)